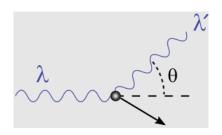
Задание 1

Вывести формулу для длины волны при эффекте Комптона:

Решение:

Определение Эффекта Комптона – упругое рассеяние фотона заряженной частицей, обычно электроном. Если рассеяние приводит к уменьшению энергии, поскольку часть энергии фотона предается отражающемуся электрону, что соответствует увеличению длины волны фотона, то это процесс называется эффектом Комптона.



Фотон с длиной волны λ падает слева и сталкивается с неподвижной мишенью, а новый фотон с длиной волны λ' рассеивается под углом θ (тета) первоначальному направлению движения. Мишень отскакивает, унося зависящее от угла количество падающей энергии.

Введем обозначения:

где: λ — начальная длина волны,

 λ' — длина волны после рассеяния,

h — постоянная Планка,

 m_e — масса покоя электрона,

c — скорость света

 θ — угол рассеяния.

Закон сохранения энергии Е сравнивает сумму энергий до и после рассеяния:

$$E_{\gamma}+E_{e}=E_{\gamma'}+E_{e'}$$

Энергия фотонов связаны с частотами соотношениями

$$E_{\gamma} = hf$$
 где h – это постоянная Планка

Так как до события рассеяния электрон рассматривается как достаточно близкий к состоянию покоя, так что его полная энергия полностью состоит из его массы покоя, исходя их его энергии для $m_{\rm e}$ выходит:

$$E_e = m_e c^2$$

После рассеяния существует возможность, что электрон может быть ускорен до значительной доли от скорости света, что означает, что его полная энергия должна быть представлена с использованием релятивистского соотношения энергия-импульса в виде:

$$E_{e'} = \sqrt{(p_{e'}c)^2 + (m_ec^2)^2}$$

Когда мы подставили эти величины в выражение для сохранения энергии получается:

$$hf + m_e c^2 = hf' + \sqrt{(p_{e'}c)^2 + (m_e c^2)^2}$$

Найдем величину импульса рассеянного электрона:

$$p_{e'}^{\,2}c^2=(hf-hf'+m_ec^2)^2-m_e^2c^4$$

=

$$rac{1}{c}\sqrt{(hf-hf'+m_ec^2)^2-m_e^2c^4}$$

Рассмотрим закон сохранения импульса:

$$\mathbf{p}_{e'} = \mathbf{p}_{\gamma} - \mathbf{p}_{\gamma'}$$

Мы можем воспользоваться скалярным произведением для того, чтобы получить квадрат его величины:

$$egin{aligned} p_{e'}^{\,2} &= \mathbf{p}_{e'} \cdot \mathbf{p}_{e'} = (\mathbf{p}_{\gamma} - \mathbf{p}_{\gamma'}) \cdot (\mathbf{p}_{\gamma} - \mathbf{p}_{\gamma'}) \ &= p_{\gamma}^{\,2} + p_{\gamma'}^{\,2} - 2 p_{\gamma} \, p_{\gamma'} \cos heta \ . \end{aligned}$$

Мы проводим замену $\rho_{\gamma}c$ на hf и умножаем обе части на c^2 . Следовательно получим:

$$p_{s'}^{\,2}c^2 = p_{\gamma}^{\,2}c^2 + p_{\gamma'}^{\,2}c^2 - 2c^2p_{\gamma}\,p_{\gamma'}\cos heta$$

Далее:

$$p_{e'}^{\,2}c^2=(hf)^2+(hf')^2-2(hf)(hf')\cos heta$$

Приравниваем алтернативные выражения для этого импульса и в итоге получаем выражение, вида:

$$(hf - hf' + m_e c^2)^2 - m_e^2 c^4 = (hf)^2 + (hf')^2 - 2h^2 ff' \cos heta
onumber \ 2hfm_e c^2 - 2hf'm_e c^2 = 2h^2 ff' \left(1 - \cos heta
ight)$$

Разделим обе стороны на $2hff'm_ec$ и получаем:

$$\frac{c}{f'} - \frac{c}{f} = \frac{h}{m_e c} \left(1 - \cos \theta \right)$$

Т.к $\lambda = \frac{c}{v}$ и $\lambda' = \frac{c}{v'}$, то тогда из нашего выражения мы можем получить формулу, которая нам и была нужна:

$$\lambda' - \lambda = rac{h}{m_e c} (1 - \cos heta)$$
 (Источник)

Задание 2

Через какой промежуток времени электрон в атоме водорода, вращающийся вокруг ядра по окружности радиусом 52 пм, упал бы на ядро вследствие потерь на излучение, если бы к нему были применимы законы классической механики и электродинамики?

Решение:

По условиям электрон в атоме водорода падает на ядро. Давайте считать, что его движение в момент падения на ядро будет равномерным.

Можно применить II закон Ньютона: $\frac{mv^2}{r} = \frac{e^2}{r^2}$

Тогда кинетическая энергия электрона будет равна: $w_k = \frac{mv^2}{2} = \frac{e^2}{2r}(1)$

Полная энергия электрона: $E = \frac{mv^2}{2} - \frac{e^2}{r} = -\frac{e^r}{2r}$ (2)

В соответсвие с классической электродинамикой, потеря энергии заряженной частицы на излучение в единицу времени определяется формулой:

$$-\frac{dE}{dt} = \frac{2e^2}{3c^3} \cdot a^2$$
 (3)

Учитывая предыдущие формулы, подставим формулу полной энергии электрона в формулу (3):

$$-\frac{e^2}{2r^2} \cdot \frac{dr}{dt} = \frac{2e^2}{3c^3} \cdot \left(\frac{e^2}{mr^2}\right)^2$$

Получим: $-r^2 dr = \frac{4}{3} \frac{e^4}{m^2 c^3} d_t$

Полученный результат проинтегрируем: левую часть уравнения от r_0 до 0, правую часть от 0 до t .

$$\int_{r_0}^{0} -r^2 dr = \int_{0}^{t} \frac{4e^4}{3c^3m^2} dt$$

$$\int_{0}^{r_{0}} r^{2} dr = \int_{0}^{t} \frac{4e^{4}}{3c^{3}m^{2}} dt$$

$$t = \frac{r_0^3 c^3 m^2}{4 \cdot e^4} = 1,477 \cdot 10^{-11} c$$

Other: $(t = 1.477 \cdot 10^{-11}c)$

Задание 3

Поясните физические принципы работы электронного микроскопа и электронной литографии. Где применяется электронная литография?

Решение:

Электронный микроскоп – прибор, позволяющий получать изображение объектов с максимальным увеличением до 10^6 раз, благодаря использованию, в отличие от оптического микроскопа, вместо светового потока, пучка электронов с энергиями 200 эВ – 400 кэВ и более.

<u>Принцип работы электронного микроскопа</u> основан на том, что из прибора исходит электронный пучок разной энергии. На образце, который используют с целью исследования, он фокусируется в виде пятна, размер которого не больше 5 нм. Благодаря этому происходит сканирование всей поверхности исследуемого объекта. Соприкасаясь с поверхностью, электронный пучок частично проникает в нее, вытесняя не только электроны, но и фотоны. Они попадают на лучевую трубку, где уже и происходит формирование изображения.

Электронная литография – это метод получения заданной структуры на поверхности с использованием облучения пленки резиста заряженными частицами или коротковолновым электромагнитным излучением.

<u>Принцип работы электронной литографии</u> заключается в том, что электронный пучок, сфокусированный на поверхность слоя вещества, чувствительного к электронному облучению, прорисовывает на нем изображение, которое обнаруживается после обработки резиста в проявителе.

Где используется электронная литография:

- 1. Для получения фотошаблонов для монолитных микросхем
- 2. Для изготовления полупроводниковых приборов, интегральных микросхем
- 3. Создание гибридных структур со сверхпроводниками
- 4. Создание элементов шириной в единицы нанометров (наноструктурирование)

(Источник 1)

(Источник 2)